

Planejamento / 2º Sem. 2006.

Aula Nº	Data	Capítulo / Tema	Arquivos	Professor
1	04/08	0. Introdução – Apresentação IE521	IE521/Apresent.	Jacobus
1	04/08	1. Evolução da Microeletrônica	Oficina/S11	Jacobus
2	11/08	1. Evolução da Microeletrônica	Oficina/S11	Jacobus
2	11/08	2a. Processo nMOS – porta Si-poli 2b. Processo MOS – porta Al.	IE521/Cap02A IE521/Cap02	
3	18/09	3a. Escalamento MOS	Cap03A	Jacobus
4	25/08	3b. Tecnologia CMOS em Si	Cap03B	Jacobus
4	25/08	4. Conceitos de cristalografia.		Doi
5	01/09	5. Obtenção de cristais de Si e de lâminas		Doi
5	01/09	6. Crescimento Epitaxial		Doi
	08/09	Feriado		
6	15/09	7. Oxidação Térmica de Si		Diniz
6	15/09	7. Oxidação Térmica de Si + SUPREM/MINIMOS & exercício		Diniz Jacobus.
7	22/09	Prova 1		
7	22/09	8. Difusão de dopantes		Diniz
8	29/09	8. Difusão de dopantes		Diniz
8	29/09	9. Implantação Iônica		Jacobus
9	06/10	9. Implantação Iônica		Jacobus
9	06/10	10. Física de Plasma		Stanislav
	13/10	Feriado		
10	20/10	11. Vácuo e Deposição de Filmes Finos por CVD		Doi
10	20/10	11. Deposição de Filmes Finos por CVD		Doi
11	27/10	12. Deposição de Filmes Finos por PVD		Doi
11	27/10	Prova 2		
	03/11	Feriado		
12	10/11	13. Corrosão por Plasma		Stanislav
12	10/11	13. Corrosão por Plasma		Stanislav
13	17/10	14. Fotolitografia		Stanislav
13	17/11	14. Fotolitografia		Stanislav
14	24/11	15. Processos Úmidos e Limpeza		Diniz
14	24/11	15. Processos Úmidos e Limpeza		Diniz
15	01/12	16. Tecnologia “Back-End”		Doi
15	01/12	16. Tecnologia “Back-End”		Doi
16	08/12	Prova 3		